

Внутрицентровое поглощение света на примесных уровнях в ИК-диапазоне

Доклад подготовила
Петрова Наталья
Студентка 506 группы
Кафедры общей физики и
молекулярной электроники
МГУ имени М.В. Ломоносова

Содержание

- Поглощение, связанное с примесными атомами. Виды примесей: мелкие, глубокие, эрбий. Донорные и акцепторные примеси. Внутрицентровое поглощение.
- Поглощение на свободных носителях в легированных полупроводниках. Спектры ИК-поглощения GaAs p-типа.
- Поглощение носителями, связанными на донорах и акцепторах. Спектры поглощения. Фототермическая ионизационная спектроскопия. Энергия связи.
- Поглощение в соединениях, легированных эрбием.

Поглощение, связанное с примесными атомами

Примеси



«Мелкие» - это примеси с энергией $W_0 < 0.1 \text{ эВ}$, являются оптимальными. Расстояние от примесного уровня до ближайшей разрешённой зоны мало по сравнению с шириной запрещённой зоны. Мелкие уровни определяют электропроводность п/п в диапазоне $T = 200-400 \text{ К}$



«Глубокие» - у них расстояние от примесного уровня до ближайшей разрешённой зоны сравнимо с шириной запрещённой зоны. Ионизуются при повышенных T , влияя на процессы рекомбинации, определяют фотоэлектрические свойства п/п.

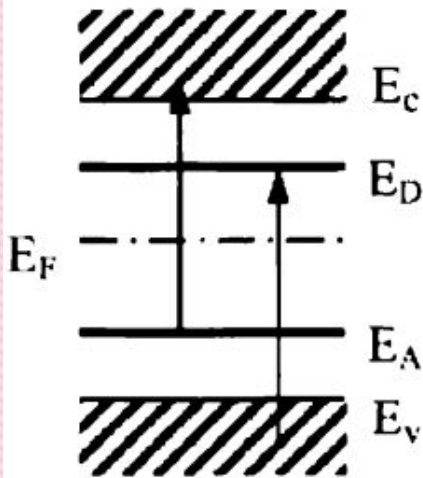


Эрбий - редкоземельный элемент, в ионизированном состоянии Er^{3+} может испускать фотон с длиной волны $1,54 \text{ мкм}$. Это происходит в результате перехода электрона внутри оболочки $4f$ между первым возбужденным и основным состоянием.

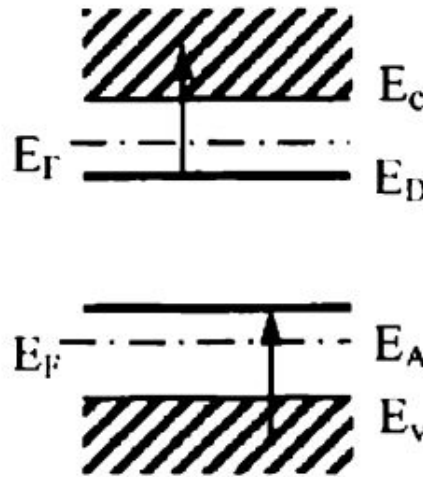
Примесное поглощение в полупроводниках при малых концентрациях примеси

Оптические переходы в полупроводнике, содержащем донорные и акцепторные примеси с уровнями энергии E_d и E_a .

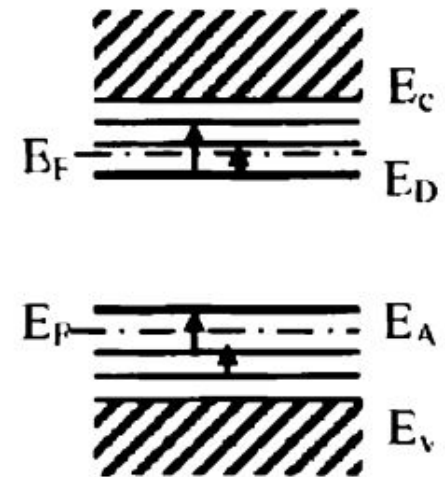
$h\nu < E_g$, предположение: атомы примеси не взаимодействуют друг с другом и образуют узкие уровни в запрещенной зоне.



E_f расположен так, что акцепторные состояния заполнены электронами (или донорные свободны), возможны переходы зона-примесь с пороговой энергией $h\nu = E_g - E_a$ (или $E_g - E_d$)



Переходы зона-примесь с пороговыми энергиями $h\nu = E_a$ (или E_d)



Примесь может образовывать состояния с набором уровней, включая основное и возбужденные $\Rightarrow$ возможны внутрицентровые переходы. В этом случае в спектре поглощения обычно наблюдается система узких линий, переходящих в более широкую

Поглощение на свободных носителях в легированных полупроводниках

Выражение Друде для свободных носителей

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_{\infty} - \frac{4\pi N_c e^2}{4\pi \varepsilon_0 m^* (\omega^2 + i\omega\gamma_c)}.$$

Реальная и мнимая части:

$$\varepsilon_r(\omega) = \varepsilon_{\infty} \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + \gamma_c^2} \right),$$

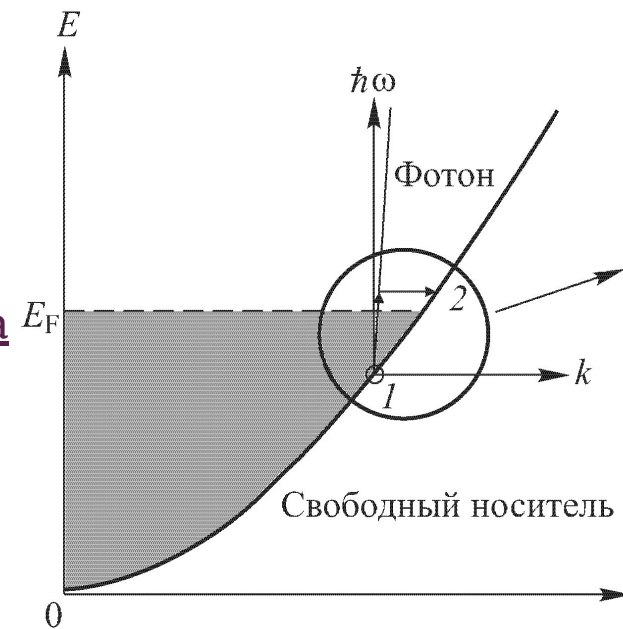
$$\varepsilon_i(\omega) = \frac{\varepsilon_{\infty} \omega_p^2 \gamma_c}{\omega (\omega^2 + \gamma_c^2)},$$

$$\omega_p^2 = 4\pi N_c e^2 / (4\pi \varepsilon_0 m^* \varepsilon_{\infty}),$$

N_c , e и m^* — плотность, заряд и эффективная масса свободных носителей соответственно, $1/\gamma_c$ — их время рассеяния, связанное с феноменологическим временем рассеяния τ .

ε_{∞} — диэлектрическая постоянная

Схематическое изображение процесса поглощения (внутризонного) на свободных носителях вблизи уровня Ферми.



Коэффициент поглощения на свободных носителях

$$\alpha_c(\omega) = \frac{\epsilon_{\infty} \omega_p^2 \gamma_c}{n_r c (\omega^2 + \gamma_c^2)},$$

n_r - реальная часть коэффициента преломления, c - скорость света.

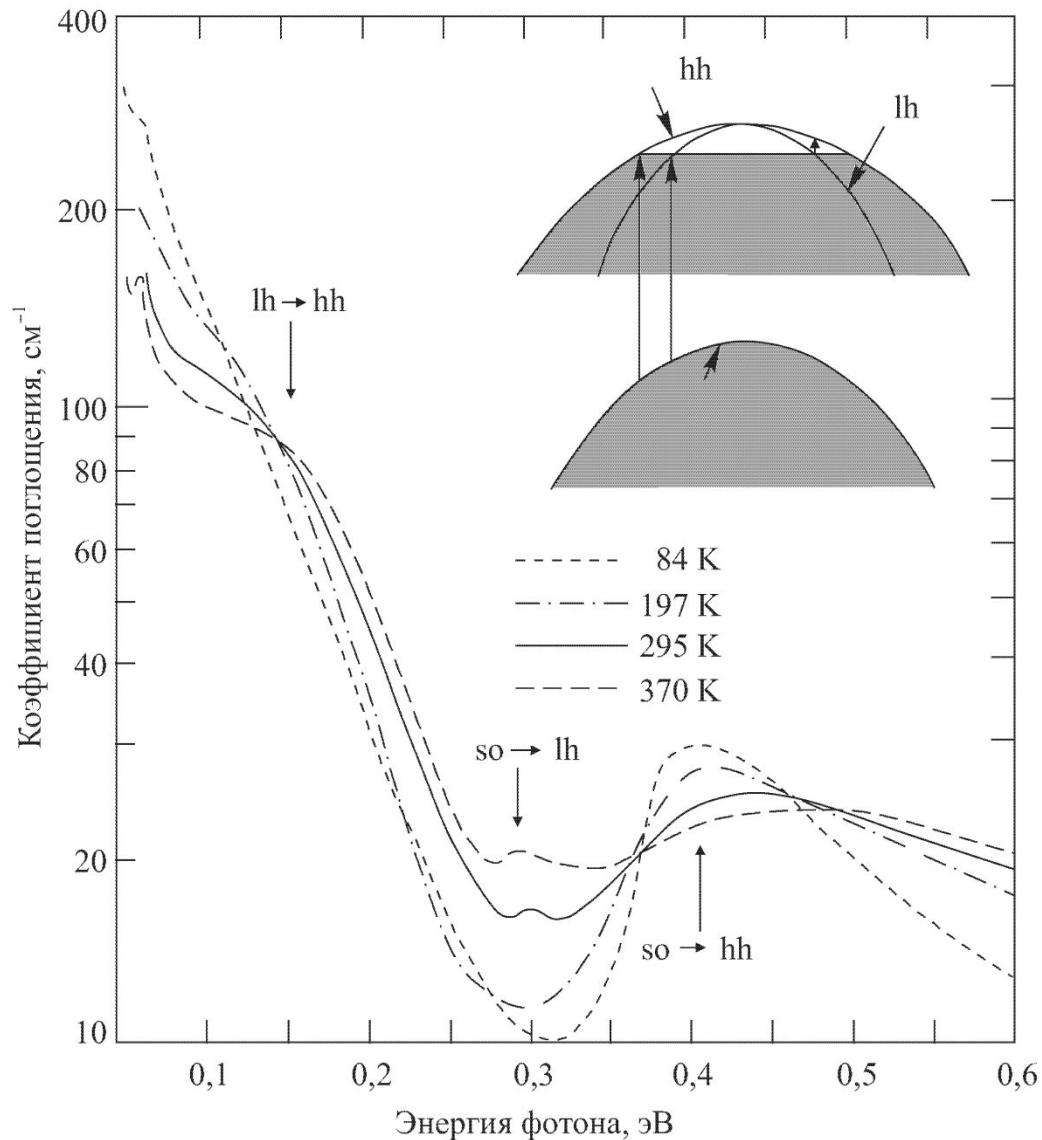
При низких частотах $\omega \ll \gamma_c$:

$$\alpha_c = \frac{4\pi N_c e^2}{4\pi \epsilon_0 n_r c m^* \gamma_c}.$$

Сравнивая коэффициент поглощения с электрической проводимостью σ :

$$\alpha_c = \frac{4\pi \sigma}{n_r c}$$

Спектры инфракрасного поглощения GaAs p-типа



На вставке показаны два внутризонных (начальное и конечное состояния электрона находятся в одной и той же зоне) перехода между спин-отщепленной дырочной зоной (so) и зонами тяжелых (hh) и легких (lh) дырок в полупроводниках типа алмаза и цинковой обманки с p-типом легирования.

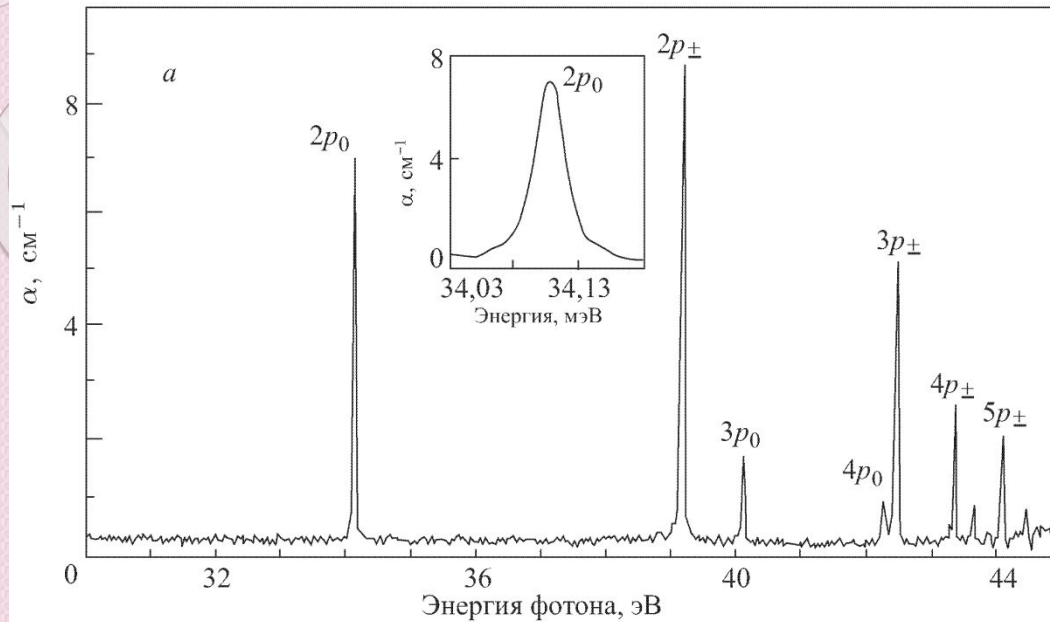
Три широких пика при 0,15; 0,31 и 0,42 эВ - переходы легкие дырки- $\rightarrow$ тяжелые дырки, спин-отщепленная дырочная зона- $\rightarrow$ легкие дырки, спин-отщепленная дырочная зона- $\rightarrow$ тяжелые дырки

Поглощение носителями, связанными на донорах и акцепторах

Мелкие доноры и акцепторы в полупроводниках типа алмаза и цинковой обманки ведут себя в какой-то мере подобно «атомам водорода в твердом теле». Хорошо известно, что атом водорода может поглощать электромагнитное излучение при электронных переходах между его квантованными уровнями. Эти переходы приводят к возникновению серий резких линий поглощения, известных как серии Лаймана, Бальмера, Пашена и др. в спектрах атомарного водорода.

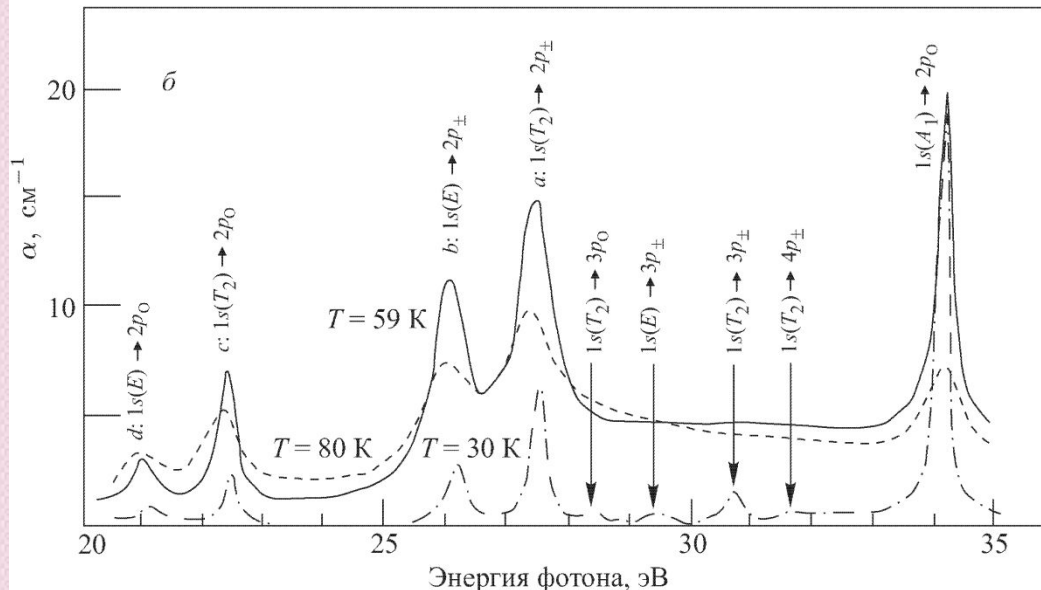
По аналогии с атомом водорода, электрон на донорном атоме или дырка на акцепторном атоме могут быть возбуждены оптически из одного связанного состояния в другое. Очевидно, что эти переходы будут подчиняться правилам отбора, подобным правилам отбора в атоме водорода, т.е. электрические дипольные переходы будут разрешены между состояниями с s - и p -симметрией (т.е. когда разница между квантовыми числами углового момента Δl равна единице), но запрещены между состояниями с одинаковой симметрией.

Спектр поглощения доноров Р в Si



Измерения при температуре жидкого гелия в образце, содержащем около $1,2 \cdot 10^{(-4)} \text{ см}^3 \text{ Р}$.

На вставке показана линия $2p_0$ с растянутой горизонтальной шкалой;

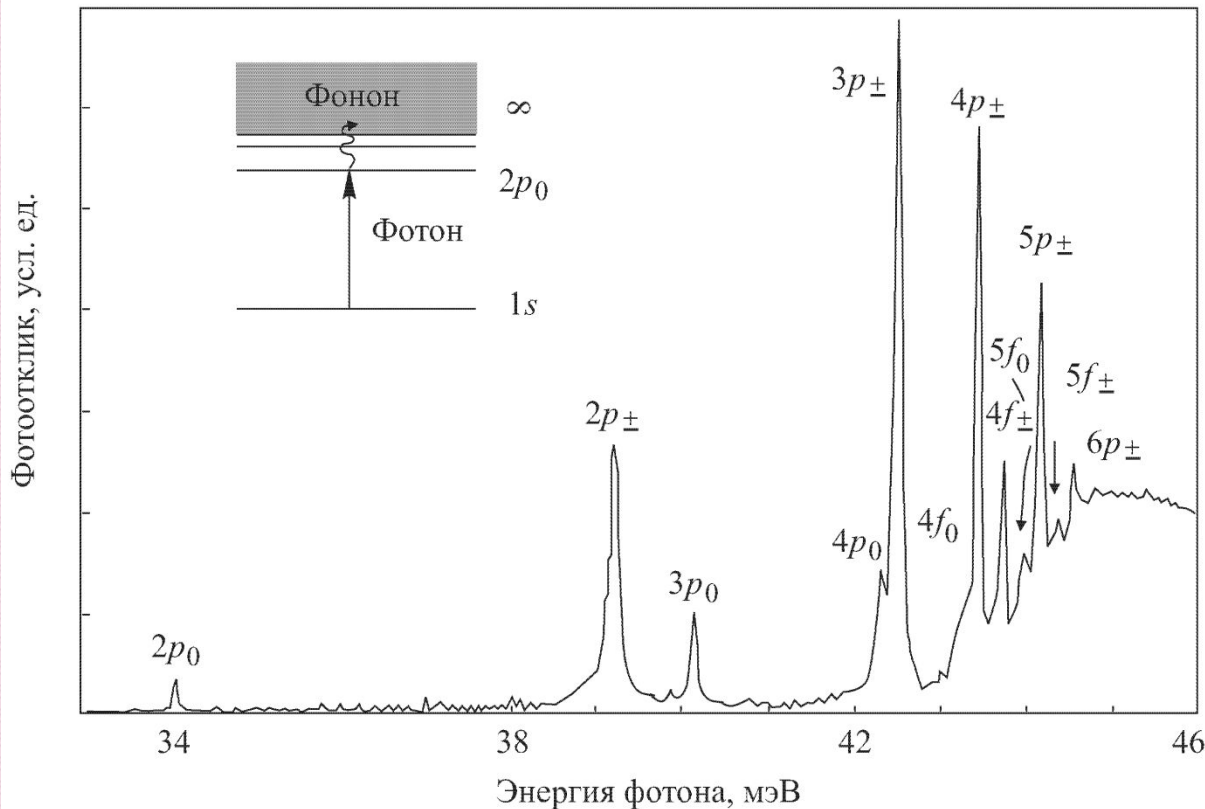


Измерения при температуре между 30 и 80 К в образце, содержащем $5,2 \cdot 10^{(-4)} \text{ см}^3 \text{ Р}$

Фототермическая ионизационная спектроскопия (ФТИС)

Основной процесс – фотопроводимость с участием фононов

Спектр ФТИС легированного фосфором Si



ФТИС может чувствовать примеси при концентрациях всего 10^8 см^{-3} !

На вставке: схематическое изображение процесса фототермической ионизации.

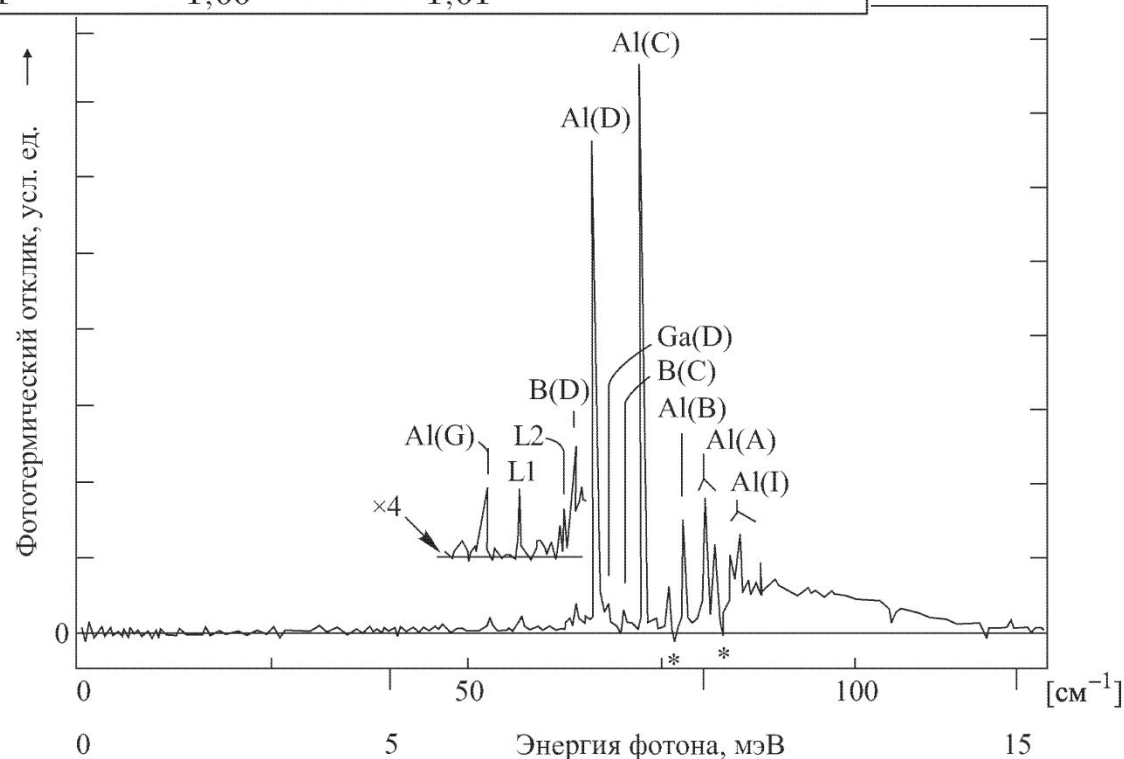
На рисунке: спектр ФТИС для концентрации в Si доноров P $\sim 2 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$

Спектр ФТИС сверхчистого p-Ge при 8К

Энергии связи акцепторов группы III в Ge, определенные методом ФТИС. Предполагается, что энергия уровня $2\Gamma_8^-$ (пик D) равна теоретическому значению [6.47] 2,88 мэВ [6.101]

Пик	Энергия связи, мэВ					Теория
	B	Al	Ga	In	Tl	
G	4,61	4,65	4,58	4,57	4,52	4, 58 ($1\Gamma_8^-$)
E	3,27		3,3	3,54	3,57	
D	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2, 88 ($2\Gamma_8^-$)
C	2,14	2,13	2,13	2,10	2,13	2, 13 ($1\Gamma_7^-$)
						2, 11 ($3\Gamma_8^-$)
a	1,76			1,76	1,78	
B	1,49	1,48	1,48	1,48	1,5	1, 48 ($4\Gamma_8^-$)
						1, 22 ($5\Gamma_8^-$)
A*	1,16	1,13	1,15	1,15	1,14	1, 14 ($2\Gamma_7^-$)
						1, 13 ($6\Gamma_8^-$)
A'	1,03	1,00	1,01	1,00	1,01	

Средняя
концентрация
акцепторов
 10^{10} см^{-3}



Поглощение в соединениях, легированных эрбием (Er)

- Эрбий является редкоземельным элементом, который в ионизированном состоянии Er^{3+} может испускать фотон с длиной волны 1,54 мкм. Это происходит в результате перехода электрона внутри оболочки 4f между первым возбужденным состоянием и основным состоянием.
- Перспектива использования такой люминесценцией связано с тем что длина волны испускаемого фотона попадает в область тах пропускания оптических волноводов на основе оксида Si. При введении ионов эрбия в кремниевую матрицу необходимое возбуждение может быть достигнуто за счет носителей исходного материала. При этом последующий переход в невозбужденное состояние может привести к эмиссии света атомного типа в узкой области спектра.
- Er-легированный кремний идеально подходит для дальнейших фундаментальных исследований, связанных с квантово-электродинамическими эффектами при спонтанном излучении.
- Оптимальная оптическая производительность наблюдается в Er-имплантированных Al_2O_3 канальных волноводах.
- В LiNbO_3 , был обнаружен новый метод, использующий высокие концентрации Er с использованием быстрого термического отжига.
- В кремниевых p-n диодах, легированных Er, наблюдается электролюминесценция при комнатной температуре на 1.54 мкм

Спектр обратного резерфордского рассеяния в пленке Al_2O_3 , легированной Er на подложке SiO_2

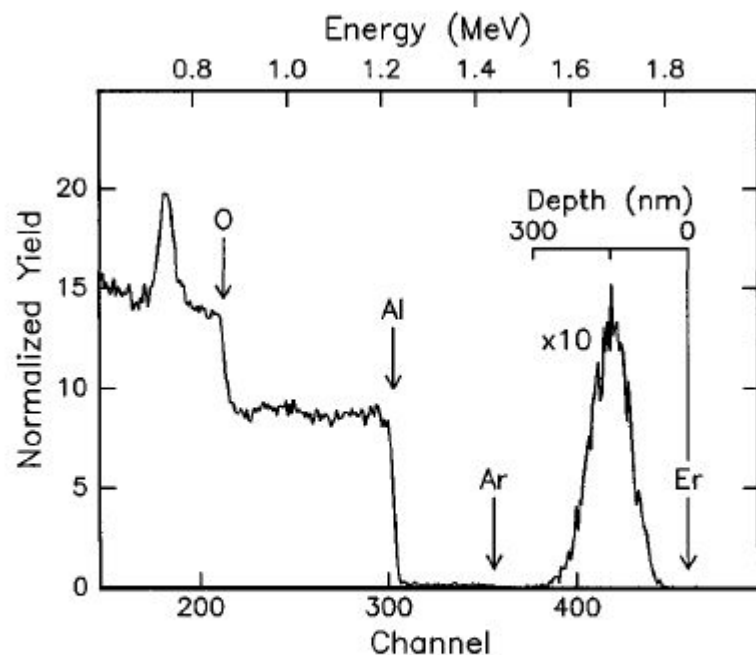


FIG. 27. Rutherford backscattering spectrum of an Er-implanted ($2.3 \times 10^{15} \text{ Er/cm}^2$, 800 keV) Al_2O_3 film on a SiO_2 buffer layer on Si. (From Ref. 60.)

Модель возбуждения и девозбуждения Er в Si

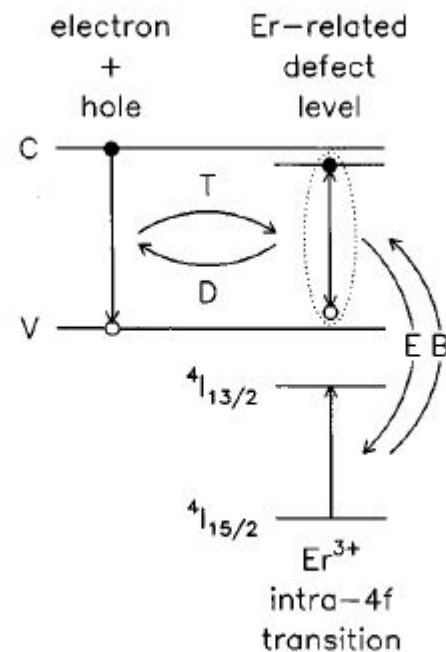


FIG. 57. Model for the excitation and deexcitation of Er in Si.

Фотолюминесценция пленки SiO_2 , легированной Er при комнатной температуре

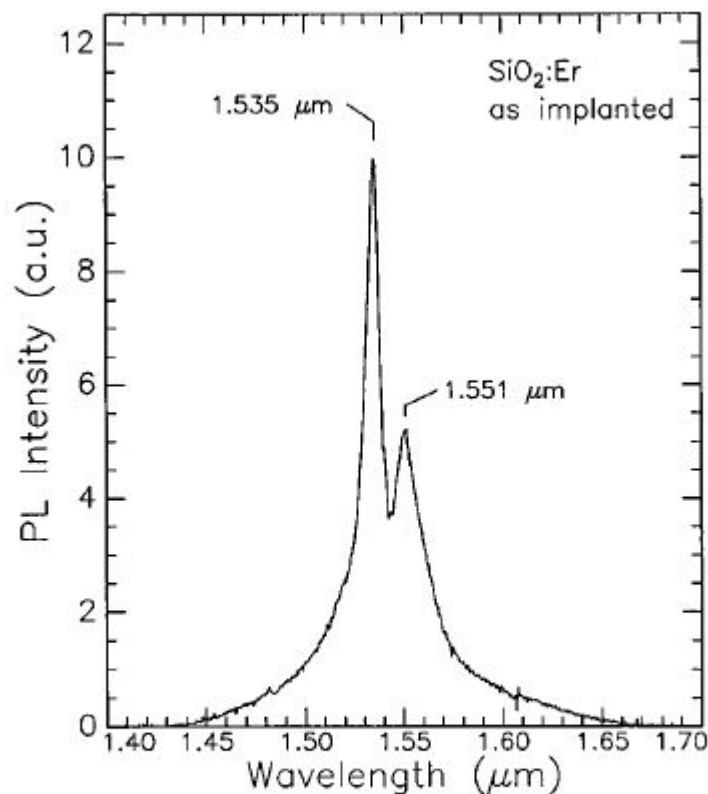


FIG. 5. Room-temperature PL spectrum for an Er-implanted ($5 \times 10^{15} \text{ Er/cm}^2$, 3.5 MeV, peak concentration 0.1 at. %) SiO_2 film on a Si substrate. ($\lambda_{\text{pump}} = 488 \text{ nm}$, pump power = 250 mW, spectral resolution = 1 nm, from Ref. 15.)



Спасибо за внимание!